

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 21.07.10.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 27.01.12 Bulletin 12/04.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO-
MIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES — FR et
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFI-
QUE — FR.

⑦2 Inventeur(s) : ZENASNI AZIZ, CORAUX JOHANN,
IVANOVA-HRISTOVA VALENTINA, LANDIS STEFAN et
PERNEL CAROLE.

⑦3 Titulaire(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMI-
QUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

⑦4 Mandataire(s) : BREVALEX.

⑤4 PROCEDE DE FABRICATION D'UNE STRUCTURE COMPRENANT UN FEUILLET DE GRAPHENE MUNI DE
PLOTS METALLIQUES, STRUCTURE AINSI OBTENUE ET SES UTILISATIONS.

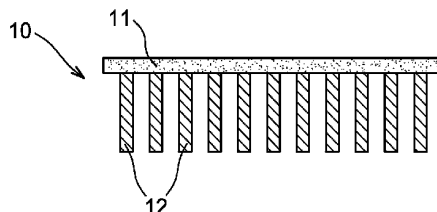
⑤7 L'invention se rapporte à un procédé de fabrication
d'une structure comprenant un feuillet de graphène qui est
muni, sur l'une de ses faces, d'une pluralité de plots métal-
liques, ces plots étant séparés les uns des autres par un mi-
lieu diélectrique choisi parmi l'air et les matériaux
diélectriques, lequel procédé est caractérisé en ce qu'il
comprend:

a) la synthèse, par croissance catalytique en phase va-
peur, du feuillet de graphène sur une pluralité de plots métal-
liques qui sont disposés sur une membrane en un
matériau diélectrique ou intégrés dans cette membrane,
cette croissance étant catalysée par lesdits plots
métalliques; et éventuellement

b) l'élimination de ladite membrane.

Elle se rapporte également à la structure ainsi obtenue
ainsi qu'aux utilisations de cette structure.

Domaines d'application: micro- et nanoélectronique, mi-
cro- et nano-électromécanique, spin-tronique, photovoltaï-
que, affichage à diodes électro-luminescentes, etc.



**PROCEDE DE FABRICATION D'UNE STRUCTURE COMPRENANT UN
FEUILLET DE GRAPHENE MUNI DE PLOTS METALLIQUES,
STRUCTURE AINSI OBTENUE ET SES UTILISATIONS**

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

L'invention se rapporte au domaine de la fabrication de feuillets de graphène.

Plus spécifiquement, l'invention se
10 rapporte à un procédé qui permet de fabriquer une structure comprenant un feuillet de graphène muni, sur l'une de ses faces, de plots métalliques, lesquels plots métalliques sont séparés les uns des autres par un milieu diélectrique choisi parmi l'air et les
15 matériaux diélectriques.

Elle se rapporte également à la structure ainsi obtenue ainsi qu'aux utilisations de cette structure.

Une structure selon l'invention est
20 susceptible d'être utilisée telle quelle dans de très nombreux domaines techniques comme :

- la micro- et la nanoélectronique, par exemple pour la fabrication de transistors du type transistors à effets de champs ou transistors à un
25 électron, ou de structures d'interconnexions pour circuits intégrés ;

- la micro- et la nanoélectromécanique, par exemple pour la fabrication de résonateurs électromécaniques micrométriques ou nanométriques, plus
30 souvent désignés par les sigles MEMS (pour « **M**icro

Electro-Mechanical Systems ») et NEMS (pour « **Nano Electro-Mechanical Systems** ») ;

- la spintronique ;
- le photovoltaïque ; ou encore
- 5 - l'affichage à diodes électroluminescentes.

Lorsque les plots métalliques de cette structure sont séparés les uns des autres par un matériau diélectrique, elle est également susceptible
10 d'être utilisée comme produit intermédiaire dans la fabrication d'une structure qui comprend un feuillet de graphène muni, sur l'une de ses faces, d'une membrane poreuse en un matériau diélectrique, ce type de structure présentant, notamment, un intérêt pour le
15 stockage de l'hydrogène, les piles à combustible ainsi que les microbatteries.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

Le graphène est un cristal bidimensionnel de carbone, qui présente une structure hexagonale en
20 nid d'abeille.

Ce cristal est doté de propriétés tout à fait surprenantes qui en font actuellement un matériau très prisé de nombreux laboratoires publics et privés.

En effet, le graphène présente, en premier
25 lieu, une mobilité électronique exceptionnelle à température ambiante, pouvant atteindre 20 m²/V.s. A titre de comparaison, la mobilité électronique de l'antimoniure d'indium est, à la température ambiante, 2,5 fois plus faible, celle du silicium est 13 fois

plus faible tandis que celle de l'argent est 2 500 fois plus faible.

De plus, le graphène est transparent puisque son épaisseur est celle d'un atome de carbone, très stable chimiquement, très léger tout en étant très résistant sur le plan mécanique (200 fois plus que l'acier).

On connaît un certain nombre de techniques permettant de synthétiser des feuillets de graphène comme l'exfoliation micromécanique d'un cristal de graphite, la réduction électrochimique d'un oxyde de graphène, l'ouverture de nanotubes de carbone, la croissance catalytique du graphène sur substrat métallique ou la sublimation du carbure de silicium.

Parmi ces techniques, la croissance catalytique du graphène sur substrat métallique (voir, par exemple, K.S. Kim et al., *Nature* (2009), 457, 706-7410, [1]) semble constituer l'une des voies les plus prometteuses pour synthétiser du graphène à une échelle industrielle et permettre son intégration dans des dispositifs du type dispositifs micro- ou nanoélectroniques, micro- ou nanoélectromécaniques ou autres, qui répondent aux normes industrielles.

En effet, par cette technique, il a été possible de produire des échantillons de graphène de haute qualité cristalline, caractérisée par des domaines monocristallins s'étendant sur plusieurs centaines de micromètres et par une orientation cristallographique unique à l'échelle macroscopique. Des échantillons de graphène aux surfaces centimétriques ont même été obtenus, ce qui n'est pas le cas

avec les autres techniques de fabrication du graphène proposées à ce jour.

Toutefois, la fabrication du graphène par croissance catalytique sur substrat métallique présente l'inconvénient majeur de nécessiter ultérieurement un transfert du feuillet de graphène du substrat métallique sur lequel il a été formé vers un support isolant si l'on veut, d'une part, caractériser ce feuillet optiquement et/ou électriquement (c'est-à-dire en étudier les propriétés optiques et/ou électriques) et, d'autre part, l'intégrer dans un dispositif du type précité (voir, par exemple, W. Regan et al., *Applied Physics Letters* (2010), 96, 113102, [2]).

Or, ce transfert met en jeu une succession d'opérations qui impliquent l'utilisation de solutions d'attaque chimique et de résines et qui ont pour effet de générer des défauts à la fois intrinsèques (c'est-à-dire dans le réseau cristallin) et extrinsèques (courbures, impuretés polaires, etc) au graphène, altérant notablement les propriétés de ce matériau.

Au surplus, pour munir le feuillet de graphène de contacts électriques en vue de son intégration dans un dispositif du type précité, il est nécessaire de procéder à des opérations supplémentaires de lithographie, de gravure et de métallisation qui augmentent encore les risques d'altération de ce feuillet.

Les Inventeurs se sont donc fixé pour but de fournir un procédé de fabrication d'un feuillet de graphène de haute qualité cristalline, qui soit exempt de tout transfert de ce feuillet d'un substrat à un

autre pour son utilisation ultérieure et, en particulier, pour sa caractérisation ou son intégration dans un dispositif du type dispositif micro- ou nanoélectronique, micro- ou nanoélectromécanique ou
5 autre, qui réponde aux normes industrielles.

Les Inventeurs se sont de plus fixé pour but que ce procédé ait des coûts de mise en oeuvre qui soient compatibles avec une exploitation à une échelle industrielle.

10 **EXPOSÉ DE L'INVENTION**

Ce but et d'autres encore sont atteints par l'invention qui propose, en premier lieu, un procédé de fabrication d'une structure comprenant un feuillet de graphène qui est muni, sur l'une de ses faces, d'une
15 pluralité de plots métalliques, ces plots étant séparés les uns des autres par un milieu diélectrique choisi parmi l'air et les matériaux diélectriques, lequel procédé est caractérisé en ce qu'il comprend :

a) la synthèse, par croissance catalytique
20 en phase vapeur, du feuillet de graphène sur une pluralité de plots métalliques qui sont disposés sur une membrane en un matériau diélectrique ou intégrés dans cette membrane, cette croissance étant catalysée par lesdits plots métalliques ; et éventuellement

25 b) l'élimination de ladite membrane.

Ainsi, selon l'invention, on fabrique une structure dans laquelle un feuillet de graphène est muni, sur l'une de ses faces, de plots métalliques et ce, sans effectuer un quelconque transfert de ce
30 feuillet d'un substrat à un autre, puisqu'il est synthétisé directement sur ces plots métalliques.

Comme, par ailleurs, les plots métalliques sur lesquels est synthétisé le feuillet de graphène sont disposés sur une membrane en un matériau diélectrique ou intégrés dans cette membrane, il
5 suffit, une fois le feuillet de graphène formé, d'éliminer ou de conserver ladite membrane pour obtenir une structure dans laquelle les plots métalliques assujettis au feuillet de graphène sont séparés les uns les autres par de l'air (si la membrane est éliminée)
10 ou par un matériau diélectrique (si la membrane est conservée).

Ce feuillet de graphène peut donc être aisément caractérisé sur le plan optique et/ou électrique.

15 Il peut également être directement intégré dans un dispositif du type dispositif de micro- ou nanoélectronique, de micro- ou nanoélectromécanique, ou autre, compte tenu que les plots métalliques dont il est muni peuvent notamment servir de contacts
20 électriques ou d'électrodes.

Dans ce qui précède et ce qui suit, l'expression « matériau diélectrique » est prise dans le sens qui lui est habituellement donné dans le domaine de l'électricité, à savoir qu'elle désigne un
25 matériau non conducteur d'un courant électrique (voir, par exemple, l'« Aide-mémoire de physique : A l'usage des élèves de l'enseignement supérieur scientifique et technique », B. Yavorski & A. Detlaf, Edition Mir, Moscou, 1975, 963 pages, [3]). En d'autres termes,
30 l'expression « matériau diélectrique » est ici synonyme de l'expression « matériau isolant électrique ».

Comme précédemment indiqué, le feuillet de graphène est synthétisé par croissance catalytique en phase vapeur en raison des avantages précédemment exposés que présente cette technique de synthèse du graphène, et ce sont les plots métalliques, qui sont disposés sur la membrane en matériau diélectrique ou intégrés dans cette membrane, qui servent de catalyseurs pour cette croissance.

Dans le cadre de l'invention, la croissance catalytique en phase vapeur du graphène peut être réalisée par toute technique qui permet d'exposer les plots métalliques à des espèces carbonées en phase gazeuse telle que :

- le dépôt chimique en phase vapeur, plus souvent désigné par le sigle CVD (pour « **C**hemical **V**apor **D**eposition »), sous toutes ses formes : CVD à pression atmosphérique (ou APCVD), CVD basse pression (ou LPCVD), CVD sous vide poussé (ou UHVCVD), CVD assisté par aérosol (ou AACVD), CVD par injection directe liquide (ou DLICVD), CVD thermique rapide (ou RTCVD), CVD initié (ou i-CVD), CVD par couche atomique (ou ALCVD), CVD à fil chaud (ou HWCVD), CVD assisté par plasma (ou PECVD), CVD assisté par plasma déporté (ou RPECVD), CVD assisté par plasma micro-ondes (ou MWPCVD), etc ;

- le dépôt physique en phase vapeur, plus souvent désigné par le sigle PVD (pour « **P**hysical **V**apor **D**eposition »), sous toutes ses formes : PVD par pulvérisation cathodique, PVD par évaporation sous vide, PVD par pulvérisation par faisceau d'ions, PVD par arc, par exemple cathodique, dépôt par laser pulsé,

plus souvent désigné par le sigle PLD (pour « **P**ulsed **L**aser **D**eposition »), etc ; et

- le dépôt hybride physico-chimique en phase vapeur, plus souvent désigné par le sigle HPCVD (pour « **H**ybrid **P**hysical-**C**hemical **V**apor **D**eposition »).

Néanmoins, on préfère que la croissance catalytique du graphène soit réalisée par dépôt chimique en phase vapeur, cette technique permettant, en effet, de particulièrement bien contrôler la qualité cristalline du feuillet de graphène obtenu.

Auquel cas, la croissance catalytique du graphène est typiquement réalisée en exposant, dans l'enceinte ou dans l'une des enceintes d'un réacteur de CVD, la membrane en matériau diélectrique munie des plots métalliques à un flux gazeux contenant un ou plusieurs hydrocarbures saturés ou insaturés, linéaires, ramifiés ou cycliques, tels que, par exemple, le méthane (CH_4), l'éthane (C_2H_6), le propane (C_3H_8), le butane (C_4H_{10}), l'acétylène (C_2H_2), l'éthylène (C_2H_4), le propylène (C_3H_6), le propyne (C_3H_4), le butylène (C_4H_8), le butyne (C_4H_6), le butadiène (C_4H_6), le benzène (C_6H_6) ou le toluène (C_7H_8), éventuellement en mélange avec de l'hydrogène ou un composé hydrogéné comme, par exemple, NH_3 (dont la présence permet de désoxyder les plots métalliques) et/ou un ou plusieurs gaz neutres du type azote, argon ou hélium, et ce, à une température allant de 200 à 2000°C et à une pression allant de l'ultravide ($P \leq 10^{-6}$ Pa) à la pression atmosphérique ($P = 101,325$ kPa).

Il se produit ainsi une décomposition des hydrocarbures présents dans le flux gazeux en espèces

carbonées, qui se déposent sur les plots métalliques et diffusent sur l'ensemble de la surface de ces plots, puis la formation de noyaux de graphène sur cette surface (nucléation) qui en s'étendant, finissent par se rejoindre et par former un feuillet continu de graphène.

De préférence, on utilise un flux gazeux comprenant un ou plusieurs hydrocarbures en C1 à C3 et, mieux encore, en C1 ou C2 comme le méthane, l'acétylène ou l'éthylène, en mélange avec de l'hydrogène, par exemple dans un rapport hydrocarbure/H₂ de 1 à 10, à une température allant de 800 à 1200°C.

De plus, on préfère que le dépôt chimique en phase vapeur soit un dépôt chimique en phase vapeur basse pression (LPCVD) dans lequel la pression utilisée est sous-atmosphérique tout en étant supérieure à 10⁻⁶ Pa.

Dans ces conditions, le temps nécessaire pour obtenir la formation d'un feuillet de graphène est typiquement de 1 à 20 minutes en fonction de la température et de la pression régnant dans l'enceinte, du flux d'agent désoxydant, du temps de désoxydation des plots métalliques, de l'épaisseur des plots métalliques et du flux d'hydrocarbure(s).

La formation du feuillet de graphène sur les plots métalliques peut être contrôlée par spectroscopie Raman, notamment en vérifiant l'apparition des deux pics caractéristiques du graphène, à savoir le pic G à 1580 cm⁻¹ et le pic 2D à 2700 cm⁻¹.

Dans la mesure où, comme précédemment mentionné, le feuillet de graphène est, de préférence, formé par croissance catalytique et où ce sont les plots métalliques, qui sont disposés sur la membrane en matériau diélectrique ou intégrés dans cette membrane, qui servent de catalyseurs pour cette croissance, ces plots sont préférentiellement constitués d'un métal ou d'un alliage de métaux dont le paramètre de maille est en adéquation avec le paramètre de maille du graphène, sachant que l'on considère qu'il y a adéquation entre ces paramètres si le paramètre de maille du métal ou des métaux de l'alliage ne diffère pas de plus de 2% de celui du graphène.

Le paramètre de maille du graphène étant de 2,45 Å, les plots métalliques sont donc, de préférence, constitués d'un métal ou d'un alliage de métaux dont le paramètre de maille est supérieur ou égal à 2,401 Å et inférieur ou égal à 2,499 Å.

Des métaux ayant un tel paramètre de maille sont, notamment, le nickel, le cuivre, le cobalt, le ruthénium, le palladium, l'iridium et le platine.

Parmi ceux-ci, on préfère tout particulièrement le nickel pour son coût, sa haute température de fusion (1455°C) et parce qu'il présente un accord de paramètre de maille particulièrement bon avec le graphène.

Il va de soi que l'utilisation de plots métalliques constitués de l'un des métaux précédemment cités ou d'un alliage de ces métaux n'est pas réservée au seul cas où ces plots sont destinés à servir de catalyseurs à l'étape a) et peut parfaitement envisagée

quelle que soit la technique employée pour former le feuillet de graphène.

Conformément à l'invention, les plots métalliques peuvent être répartis sur la membrane en
5 matériau diélectrique ou dans cette membrane de façon quelconque. De manière similaire, ces plots peuvent avoir des dimensions quelconques et être séparés les uns des autres par des distances quelconques.

Toutefois, on préfère que les plots
10 métalliques soient répartis de façon ordonnée et, plus spécialement, qu'ils forment un réseau, c'est-à-dire un ensemble de lignes parallèles entre elles et de colonnes perpendiculaires à ces lignes.

Auquel cas, ce réseau est, de préférence, à
15 pas régulier, c'est-à-dire que la distance qui sépare deux plots adjacents est constante ou sensiblement constante.

Par ailleurs, on préfère que la plus grande étendue des plots métalliques mesurée dans une
20 direction parallèle au plan de la membrane en matériau diélectrique - qui correspond au diamètre de ces plots dans le cas où ils ont la forme d'un cylindre de révolution ou sensiblement cette forme - soit de dimension nanométrique, et que la distance qui sépare
25 deux plots métalliques adjacents soit, elle-aussi, de dimension nanométrique.

Dans ce qui précède et ce qui suit, on qualifie de « nanométrique », une dimension qui est au moins égale à 1 nanomètre mais qui est inférieure à 1
30 micromètre.

De préférence, le procédé selon l'invention comprend, de plus, une étape de réalisation des plots métalliques, laquelle étape comprend le remplissage d'ouvertures que comporte un support avec un métal ou
5 un alliage métallique.

En liaison avec ce qui précède, on préfère que les ouvertures de ce support soient réparties de façon ordonnée et, plus spécialement, qu'elles forment un réseau, c'est-à-dire un ensemble de lignes
10 parallèles entre elles et de colonnes perpendiculaires à ces lignes et que ce réseau soit à pas régulier, c'est-à-dire que la distance qui sépare deux plots adjacents est constante ou sensiblement constante.

Par ailleurs, on préfère que la plus grande
15 étendue des ouvertures du support mesurée dans une direction parallèle au plan de ce support soit de dimension nanométrique et que la distance qui sépare deux ouvertures adjacentes de ce support soit, elle aussi, de dimension nanométrique.

De manière particulièrement préférée, le
20 support est constitué par la membrane en matériau diélectrique et les ouvertures de ce support correspondent à des pores que comporte cette membrane, avant remplissage desdites ouvertures par le métal ou
25 l'alliage métallique, qui forment un réseau et dont la plus grande étendue mesurée dans une direction parallèle au plan de ladite membrane est de dimension nanométrique.

Cette membrane peut notamment être une
30 membrane d'alumine, de silice, d'un matériau de formule $\text{Si}_v\text{O}_w\text{C}_x\text{H}_z$ ou $\text{Si}_v\text{O}_w\text{C}_x\text{N}_y\text{H}_z$ dans laquelle v , w , x , y et z

tous différents de 0, d'un polymère tel qu'un polycarbonate ou un polyéthylènetéréphtalate, ou d'un copolymère séquencé tel qu'un copolymère de polyméthacrylate de méthyle et de polyoxyde d'éthylène (PPMA/POE).

Des membranes de ce type sont pour certaines, disponibles dans le commerce (membranes de polycarbonate et de polyéthylènetéréphtalate par exemple). Quand ce n'est pas le cas, elles peuvent être réalisées par des procédés d'oxydation anodique (par exemple, dans le cas d'une membrane d'alumine) qui permet d'obtenir une grande densité de pores (10^9 - 10^{12} pores/cm³) présentant un diamètre de 10 à 500 nm, de lithographie ou photolithographie suivie d'une gravure sélective, de nanoimpression assistée par UV, tous ces procédés étant bien connus de l'homme du métier.

Avantageusement, les pores de la membrane en matériau diélectrique sont des pores traversants, ce qui permet de réaliser le remplissage de ces pores par électrodéposition qui est une technique hautement sélective tout en étant peu coûteuse.

Toutefois, d'autres techniques peuvent être utilisées pour le remplissage des pores comme le dépôt chimique en phase vapeur (PVD), le dépôt de couches atomiques (ALD pour « **A**tomical **L**ayer **D**eposition »), le dépôt de couches atomiques assisté par plasma (PEALD pour « **P**lasma-**E**nhanced **A**tomical **L**ayer **D**eposition ») ou encore le dépôt chimique métallo-organique en phase vapeur (MOCVD pour « **M**etal **O**rganic **C**hemical **V**apor **D**eposition »).

L'invention a également pour objet une structure telle qu'obtenue par le procédé précédemment décrit.

Cette structure est caractérisée en ce
5 qu'elle comprend un feuillet de graphène qui est muni, sur l'une de ses faces, de plots métalliques, ces plots étant séparés les uns des autres par un milieu diélectrique choisi parmi l'air et les matériaux diélectriques.

10 L'invention a encore pour objet les utilisations de cette structure.

Comme précédemment indiquée, cette structure est susceptible d'être utilisée, en premier lieu, telle quelle dans la fabrication de dispositifs
15 micro- ou nanoélectroniques, micro- ou nanoélectromécaniques, spintroniques, photovoltaïques ou d'affichage à diodes électroluminescentes.

Toutefois, lorsque le milieu diélectrique qui sépare les plots métalliques est un matériau
20 diélectrique, elle est également susceptible d'être utilisée dans la fabrication d'une structure comprenant un feuillet de graphène muni, sur l'une de ses faces, d'une membrane poreuse en un matériau diélectrique.

Auquel cas, cette utilisation comprend
25 l'élimination des plots métalliques de ladite structure.

La structure ainsi obtenue présente notamment un intérêt pour la réalisation de dispositifs dévolus au stockage de l'hydrogène, de piles à
30 combustible et de microbatteries.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront du complément de description qui suit, qui se rapporte à des exemples de mise en œuvre du procédé selon l'invention et qui se réfère aux
5 figures annexées.

Dans ces exemples, on appelle « nanoplots », « nanopores » et « nanofils », des plots, des pores et des fils ayant la forme d'un cylindre de révolution ou sensiblement cette forme et
10 dont le diamètre est nanométrique.

Il va de soi que ces exemples ne sont donnés qu'à titre d'illustrations de l'objet de l'invention et ne constituent en aucun cas une limitation de cet objet.

15 **BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES**

Les figures 1A à 1D illustrent, sous une forme schématique, un premier mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention, conçu pour fabriquer une structure comprenant un feuillet de graphène qui est
20 muni, sur l'une de ses faces, d'un réseau de nanoplots métalliques à pas régulier, et dans laquelle ces nanoplots sont séparés les uns des autres par de l'air.

Les figures 2A à 2C illustrent, sous une forme schématique, un deuxième mode de mise en œuvre du
25 procédé selon l'invention, conçu pour fabriquer une structure comprenant un feuillet de graphène qui est muni, sur l'une de ses faces, d'un réseau de nanoplots métalliques à pas régulier, et dans laquelle ces nanoplots sont séparés par un matériau diélectrique.

30 La figure 3 illustre, sous une forme schématique, une structure comprenant un feuillet de

graphène qui est muni, sur l'une de ses faces, d'une membrane poreuse en un matériau diélectrique, et ayant été obtenue à partir de la structure illustrée sur la figure 2C.

5 Pour des raisons de clarté, les dimensions des différents éléments représentés sur ces figures ne sont pas en proportion avec leurs dimensions réelles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE MISE EN ŒUVRE PARTICULIERS

Exemple 1 :

10 On se réfère tout d'abord aux figures 1A à 1D qui illustrent schématiquement un premier mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention, conçu pour fabriquer une structure 10 qui, comme visible sur la figure 1D, comprend un feuillet de graphène 11 qui est
15 solidaire d'un réseau, à pas régulier, de nanoplots métalliques 12, plus précisément de nickel, et dans laquelle ces nanoplots sont séparés les uns des autres par de l'air.

 Dans ce mode de mise en œuvre, le procédé
20 selon l'invention comprend les 4 étapes suivantes :

 1) la préparation d'une membrane d'alumine comportant un réseau de nanopores traversants, à pas régulier, par oxydation anodique d'une feuille d'aluminium ;

25 2) l'élaboration de nanofils de nickel dans les nanopores de la membrane d'alumine ainsi réalisée, par électrodéposition ;

 3) la synthèse d'un feuillet de graphène sur la surface des nanofils ainsi élaborés, par LPCVD ;
30 puis

4) l'élimination de la membrane d'alumine par gravure chimique.

Ces étapes sont décrites de manière détaillée ci-après.

5 * Préparation de la membrane nanoporeuse d'alumine :

Une feuille d'aluminium mesurant 1 μm d'épaisseur est, tout d'abord, soumise à un recuit sous atmosphère neutre (argon, hélium ou azote), pendant 2 heures à 500°C, pour renforcer la taille des grains du métal et obtenir des conditions homogènes de croissance des nanopores lors des opérations ultérieures d'oxydation anodique.

Puis, cette feuille est immergée pendant 30 secondes dans une solution à 5% de soude, préalablement chauffée à 60°C, pour la décaper, après quoi elle est immergée pendant 10 secondes dans une solution aqueuse d'acide nitrique 1,5 M pour la neutraliser.

L'une des faces de la feuille d'aluminium est ensuite soumise à un électropolissage pendant 20 secondes, que l'on réalise à température ambiante, dans un bain standard d'électropolissage (acide perchlorique à 65%/éthanol/2-butoxyéthanol/eau), et en appliquant une tension continue de 40 volts entre cette feuille, qui sert d'anode, et une contre-électrode constituée d'une plaque de graphite.

La rugosité moyenne de la face ainsi électropolie est d'environ 3 nm sur une zone de 3 μm^2 .

Cette face est alors soumise à une première oxydation anodique d'une durée de 15 heures, que l'on réalise dans un bain à température de 15°C, dans une

solution aqueuse à 3% d'acide oxalique à 0,5 M, et en appliquant une tension continue de 40 volts entre la feuille d'aluminium, qui sert d'anode, et une contre-électrode consistant en une grille de platine.

5 La couche d'alumine formée au cours de cette oxydation anodique est éliminée par une gravure humide, que l'on réalise à 60°C en utilisant une solution aqueuse contenant 0,2 mole/L d'acide chromique et 0,4 mole/L d'acide phosphorique.

10 Puis, la face précédemment anodisée de la feuille d'aluminium est soumise à une deuxième oxydation anodique d'une durée de 5 heures, que l'on réalise dans les mêmes conditions que celles de la première oxydation anodique.

15 On obtient ainsi la membrane d'alumine 14 qui est illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 1A et qui présente un réseau de nanopores traversants 15.

 Ces nanopores ont un diamètre moyen de
20 70 nm environ et sont séparés les uns des autres par une distance sensiblement constante, de l'ordre de 110 nm.

* Elaboration des nanofils de nickel :

 Les nanofils de nickel étant élaborés par
25 électrodéposition, il est nécessaire de rendre conductrices les extrémités des nanopores qui débouchent sur l'une des faces de la membrane d'alumine avant de procéder à cette électrodéposition.

 De ce fait, une couche d'or de 10 nm
30 d'épaisseur est, tout d'abord, déposée sur l'une des faces de la membrane d'alumine par évaporation sous

vide, en utilisant un masque pour que ce dépôt n'ait lieu que sur les extrémités des nanopores débouchant sur cette face.

Puis, l'électrodéposition est réalisée, à
5 la température de 20°C, dans un bain électrolytique composé de 200 g/L d'un mélange de chlorure de nickel (NiCl_2) et d'eau (1/1, v/v), de 120 g/L d'un mélange de sulfate de nickel (NiSO_4) et d'eau (1,7, v/v), et de 50 g/L d'acide borique, et dont le pH a été
10 préalablement ajusté à 4 par addition de soude, en appliquant pendant 90 minutes une tension continue de 10 volts entre l'électrode de travail, qui est constituée par la couche d'or recouvrant les extrémités des nanopores, et une contre-électrode qui est
15 constituée d'une plaque d'acier inoxydable.

Le nickel déposé en excès, c'est-à-dire correspondant à la partie des nanofils s'étant formée en dehors des nanopores de la membrane d'alumine, est éliminé par un polissage mécano-chimique sélectif,
20 lequel est réalisé en utilisant une solution à 0,1% de peroxyde d'hydrogène comme oxydant, et un slurry à 4,6% en poids de particules d'alumine mesurant en moyenne 180 nm de diamètre comme abrasif. La vitesse linéaire de polissage est de 10 cm/minute et la pression
25 appliquée est de 5,1 psi (34,47 kPa). Le temps de polissage pour chaque parcours est ajusté en fonction de l'épaisseur du nickel devant être éliminé.

On obtient ainsi la structure qui est illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 1B
30 et dans laquelle la membrane d'alumine 14 comprend un réseau de nanoplots de nickel 12 qui sont intégrés dans

cette membrane et dont l'une des extrémités, référencée 17, affleure l'une des faces, référencée 18, de ladite membrane.

Ces nanoplots de nickel, dont le diamètre
5 moyen et l'espacement sont les mêmes que ceux des nanopores dans lesquels ils ont été formés (70 nm environ pour le diamètre, 110 nm environ pour l'espacement), sont propres à servir de catalyseurs dans l'étape suivante.

10 * Synthèse du feuillet de graphène :

La structure illustrée sur la figure 1B est introduite dans l'enceinte d'un réacteur de LPCVD, et disposée sur une plaque dont on porte la température à 1000°C par pas de 50°C et que l'on maintient à cette
15 température pendant 10 minutes, sous une pression de 0,5 torr (0,0666 kPa) et un flux d'argon de 200 cm³/minute.

Puis, les conditions de température et de pression étant maintenues constantes, la structure est
20 successivement soumise à :

- un flux d'hydrogène (ayant un rôle désoxydant) de 1000 cm³/minute pendant 2 minutes ; et
- un flux d'hydrogène de 1000 cm³/minute auquel on ajoute un flux d'éthylène de 200 cm³/minute.

25 Après quoi, elle est refroidie soit dans l'enceinte du réacteur de LPCVD soit dans une chambre dévolue à cet effet, sous vide ou sous atmosphère d'un gaz neutre du type azote, argon ou hélium, à raison de 10°C/minute.

30 On obtient ainsi la structure qui est illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 1C

et qui comprend un feuillet de graphène 11 s'étendant sur toute la face 18 de la membrane d'alumine 14 et s'étant formé par nucléation de graphène sur les nanoplots de nickel 12, croissance des noyaux ainsi
5 constitués en plans de graphène et confluence de ces plans.

* Elimination de la membrane d'alumine :

La membrane d'alumine de la structure illustrée sur la figure 1C est éliminée par une gravure
10 chimique que l'on réalise en immergeant pendant 10 minutes la structure dans une solution aqueuse de soude 2 M dont la température est de 20°C. Après quoi, la structure est rincée à l'eau désionisée plusieurs fois (au moins 5 fois) puis elle est séchée pendant 30
15 minutes dans une enceinte chauffée à 300°C, sous un flux d'azote.

On obtient ainsi la structure 10 qui est illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 1D, qui comprend un feuillet de graphène 11 qui est
20 solidaire du réseau de nanoplots de nickel 12 et dans laquelle ces nanoplots sont séparés les uns des autres par de l'air.

Exemple 2 :

On se réfère à présent aux figures 2A à 2C
25 qui illustrent schématiquement un deuxième mode de mise du procédé selon l'invention qui se distingue du précédent en ce qu'il est conçu pour fabriquer une structure dans laquelle les nanoplots de nickel sont séparés les uns des autres par un matériau
30 diélectrique, en l'espèce du SiOCH.

De ce fait, dans ce mode de mise en œuvre, le procédé selon l'invention comprend les 3 étapes suivantes :

1) la préparation, par PECVD suivi d'une lithographie par faisceau d'électrons, d'une membrane de SiOCH comportant un réseau de nanopores traversants, à pas régulier ;

2) l'élaboration, par électrodéposition, de nanofils de nickel dans les nanopores de la membrane ainsi réalisée ; et

3) la synthèse, par LPCVD, d'un feuillet de graphène sur les nanofils de nickel ainsi élaborés.

* Préparation de la membrane nanoporeuse de SiOCH :

Une couche de nickel de 5 nm d'épaisseur est, tout d'abord, déposée par PVD sur la surface d'un substrat de silicium d'orientation cristalline de 100, en utilisant un masque permettant de déposer cette couche de nickel uniquement sur des zones prédéterminées, correspondant aux futurs emplacements des nanopores de la membrane de SiOCH prévue pour être formée ensuite sur ce substrat.

Puis, une couche de SiOCH de 200 nm d'épaisseur est déposée par PECVD sur la face du substrat partiellement recouverte de nickel.

Ce dépôt est réalisé dans l'une des chambres à couplage capacitif d'une Centura™ DXZ 200 nm de la société Applied Materials, en disposant le substrat sur un porte-substrat chauffé à 300°C et en utilisant les paramètres opératoires suivants :

- plasma radiofréquence : 13,56 MHz ;
- pression de travail : 5 torrs (666 Pa) ;

- puissance : 600 W ;
- flux de diéthoxyméthylsilane (DEMS) :
1000 cm³/min ;
- flux d'hélium : 1000 cm³/min ;
- 5 - durée du dépôt : 30 secondes.

Après refroidissement, la couche de SiOCH ainsi formée est soumise à une lithographie par faisceau d'électrons, que l'on réalise comme décrit par T. Raluca et al. dans *Microelectronic Engineering*
10 (2006), 83, 926, [4], en utilisant un masque pour que le fond des nanopores formés par cette lithographie dans ladite couche de SiOCH coïncide avec les zones du substrat ayant été recouvertes de nickel.

On obtient ainsi la structure qui est
15 illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 2A.

Cette structure comprend un substrat de silicium 23 qui est localement recouvert d'une couche de nickel 25, lesquels sont eux-mêmes recouverts d'une membrane de SiOCH 24 qui présente un réseau de
20 nanopores traversants 26, dont le diamètre moyen est de 40 nm environ et qui sont séparés les uns des autres par une distance constante de l'ordre de 40 nm.

* Elaboration des nanofils de nickel :

Les nanofils de nickel sont réalisés en
25 suivant le même protocole d'électrodéposition que celui utilisé dans l'exemple 1 ci-avant à ceci près que, dans ce cas, c'est la couche de nickel 25 qui sert d'électrode de travail.

Là également, le nickel déposé en excès,
30 c'est-à-dire correspondant à la partie des nanofils s'étant formée en dehors des nanopores de la membrane

d'alumine, est éliminé par un polissage mécano-chimique sélectif, que l'on réalise de la même manière que dans l'exemple 1 ci-avant.

On obtient ainsi la structure qui est
5 illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 2B et dans laquelle la membrane de SiOCH 24 comprend un réseau de nanoplots de nickel 22 qui sont intégrés dans cette membrane et dont les extrémités affleurent chacune l'une des faces de ladite membrane.

10 Ces nanoplots de nickel, dont le diamètre moyen et l'espacement sont les mêmes que ceux des nanopores dans lesquels ils ont été formés (40 nm environ pour le diamètre, 40 nm environ pour l'espacement), sont propres à servir de catalyseurs
15 dans l'étape suivante.

* Synthèse du feuillet de graphène :

Le feuillet de graphène est synthétisé en suivant le même protocole de LPCVD que celui utilisé dans l'exemple 1 ci-avant.

20 On obtient, à l'issue de cette étape, la structure 20 qui est illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 2C.

Cette structure comprend un feuillet de graphène 21 qui s'étend sur toute la face, référencée
25 28, de la membrane de SiOCH 24 qui est opposée à celle en contact avec le substrat de silicium 23, et qui s'est formé par nucléation de graphène sur les nanoplots de nickel 22 de cette membrane, croissance des noyaux ainsi constitués en plans de graphène et
30 confluence de ces plans.

Cette structure peut être utilisée telle quelle, par exemple dans des structures d'interconnexions pour circuits intégrés ou des nanosystèmes électromécaniques (NEMS).

5 Toutefois, pour d'autres applications, il est possible, de retirer les nanoplots de nickel 22 de la membrane de SiOCH 24, par exemple par une gravure humide que l'on réalise en immergeant quelques minutes la structure 20 dans une solution aqueuse de chlorure
10 ferrique (ClFe_3) 1 M.

 Une gravure de ce type permet, en effet, de retirer les nanoplots de nickel 22 de la structure 20 sans que des produits gazeux ou des précipités ne se forment et, par conséquent, sans que le feuillet de
15 graphène 21 ne soit endommagé.

 On obtient ainsi la structure 30 qui est illustrée, vue en coupe transversale, sur la figure 3.

 Cette structure comprend un feuillet de graphène 31 qui s'étend sur l'une des faces, référencée
20 38, d'une membrane nanoporeuse de SiOCH 34.

REFERENCES CITEES

- [1] K.S. Kim et al., *Nature* (2009), 457, 706-7410
- [2] W. Regan et al., *Applied Physics Letters* (2010), 96, 113102
- 25 [3] « Aide-mémoire de physique : A l'usage des élèves de l'enseignement supérieur scientifique et technique », B. Yavorski & A. Detlaf, Edition Mir, Moscou, 1975, 963 pages
- [4] T. Raluca et al., *Microelectronic Engineering*
30 (2006), 83, 926

REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication d'une structure comprenant un feuillet de graphène qui est muni, sur
5 l'une de ses faces, d'une pluralité de plots métalliques, ces plots étant séparés les uns des autres par un milieu diélectrique choisi parmi l'air et les matériaux diélectriques, lequel procédé est caractérisé en ce qu'il comprend :

10 a) la synthèse, par croissance catalytique en phase vapeur, du feuillet de graphène sur une pluralité de plots métalliques qui sont disposés sur une membrane en un matériau diélectrique ou intégrés dans cette membrane, cette croissance étant catalysée
15 par lesdits plots métalliques ; et éventuellement

b) l'élimination de ladite membrane.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la croissance catalytique du
20 graphène est réalisée par dépôt chimique en phase vapeur.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le dépôt chimique en phase vapeur
25 est réalisé en utilisant un flux gazeux comprenant un ou plusieurs hydrocarbures, éventuellement en mélange avec de l'hydrogène et/ou un ou plusieurs gaz neutres, à une température allant de 200 à 2000°C et à une pression allant de l'ultravide à la pression
30 atmosphérique.

4. Procédé selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisé en ce que le dépôt chimique en phase vapeur est réalisé en utilisant un flux gazeux comprenant un ou plusieurs hydrocarbures en C1 à C3 et, de préférence, en C1 ou C2, éventuellement en mélange avec de l'hydrogène ou un composé hydrogéné et/ou un ou plusieurs gaz neutres, à une température allant de 800 à 1200°C et à une pression inférieure à la pression atmosphérique mais supérieure à 10^{-6} Pa.

10

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les plots métalliques sont constitués d'un métal ou d'un mélange de métaux dont le paramètre de maille ne diffère pas de plus de 2% de celui du graphène.

15

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que les plots métalliques sont constitués d'un métal ou d'un mélange de métaux choisis parmi le nickel, le cuivre, le cobalt, le ruthénium, le palladium, l'iridium et le platine.

20

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que les plots métalliques sont constitués de nickel.

25

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les plots métalliques forment un réseau.

30

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le réseau est à pas régulier.

10. Procédé selon la revendication 8 ou la
5 revendication 9, caractérisé en ce que la plus grande étendue des plots métalliques mesurée dans une direction parallèle au plan de la membrane en matériau diélectrique est de dimension nanométrique.

10 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la distance qui sépare deux plots métalliques adjacents est de dimension nanométrique.

15 12. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend, de plus, une étape de réalisation des plots métalliques, laquelle étape comprend le remplissage d'ouvertures que comporte un support avec un métal ou
20 un alliage métallique.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que les ouvertures du support forment un réseau.

25

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que le réseau est à pas régulier.

15. Procédé selon l'une quelconque des
30 revendications 12 à 14, caractérisé en ce que la plus grande étendue des ouvertures du support mesurée dans

une direction parallèle au plan de ce support est de dimension nanométrique.

16. Procédé selon l'une quelconque des
5 revendications 12 à 15, caractérisé en ce que la distance qui sépare deux ouvertures adjacentes du support est de dimension nanométrique.

17. Procédé selon l'une quelconque des
10 revendications 12 à 16, caractérisé en ce que le support est constitué par la membrane en matériau diélectrique et en ce que les ouvertures de ce support correspondent à des pores que comporte cette membrane, avant remplissage desdites ouvertures par le métal ou
15 l'alliage métallique, qui forment un réseau et dont la plus grande étendue mesurée dans une direction parallèle au plan de ladite membrane est de dimension nanométrique.

20 18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que la membrane en matériau électrique est une membrane d'alumine, de silice, d'un matériau de formule $\text{Si}_v\text{O}_w\text{C}_y\text{H}_z$ ou $\text{Si}_v\text{O}_w\text{C}_x\text{N}_y\text{H}_z$ dans laquelle v , w , x , y et z tous différents de 0, d'un polymère ou
25 d'un copolymère séquencé.

19. Structure, caractérisée en ce qu'elle comprend un feuillet de graphène qui est muni, sur l'une de ses faces, de plots métalliques, ces plots
30 étant séparés les uns des autres par un milieu

diélectrique choisi parmi l'air et les matériaux diélectriques.

20. Utilisation d'une structure telle que
5 définie dans la revendication 19 dans la fabrication de dispositifs micro- ou nanoélectroniques, micro- ou nanoélectromécaniques, spintroniques, photovoltaïques ou d'affichage à diodes électroluminescentes.

10 21. Utilisation d'une structure telle que définie dans la revendication 19 et dans laquelle le milieu diélectrique qui sépare les plots métalliques est un matériau diélectrique, dans la fabrication d'une structure comprenant un feuillet de graphène qui est
15 muni, sur l'une de ses faces, d'une membrane poreuse en un matériau diélectrique, laquelle utilisation comprend l'élimination des plots métalliques de la structure telle que définie dans la revendication 19.

FIG. 1A

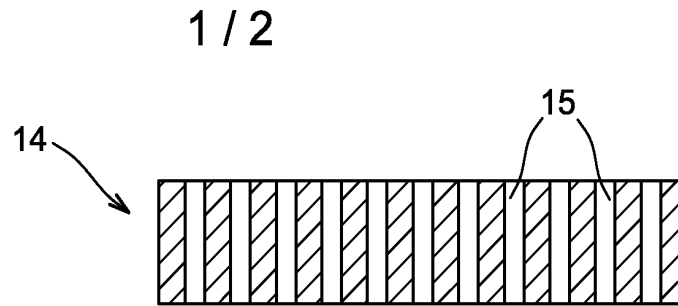


FIG. 1B

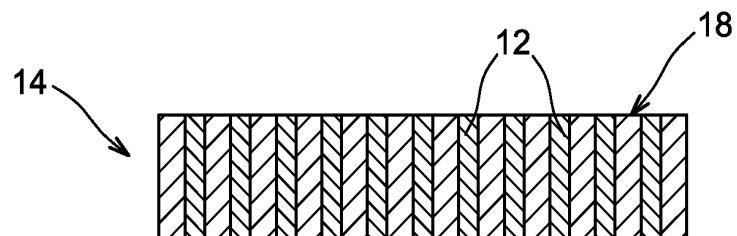


FIG. 1C

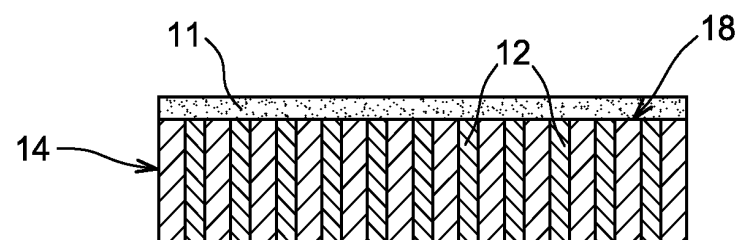
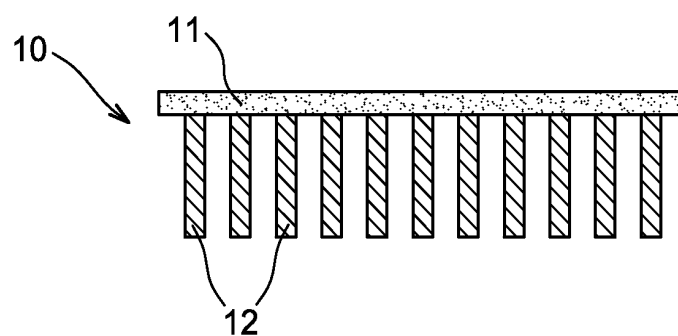


FIG. 1D



2 / 2

FIG. 2A

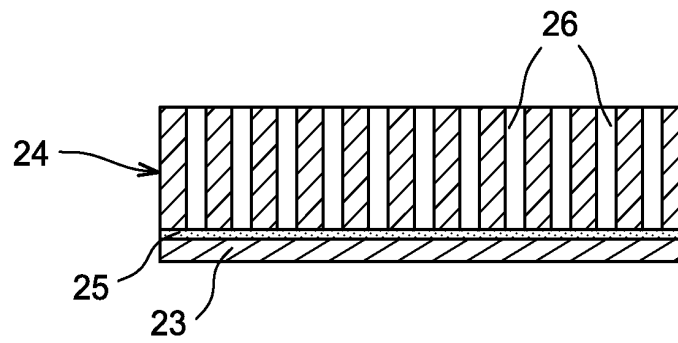


FIG. 2B

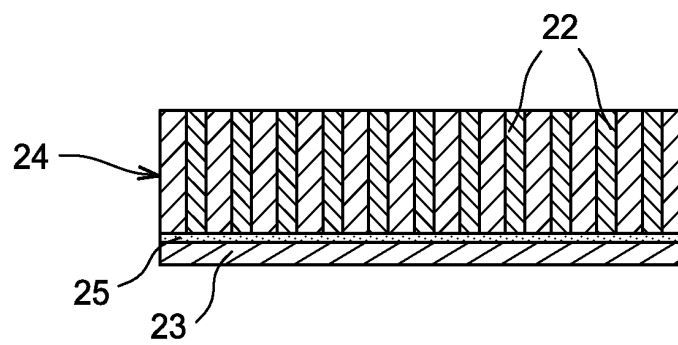


FIG. 2C

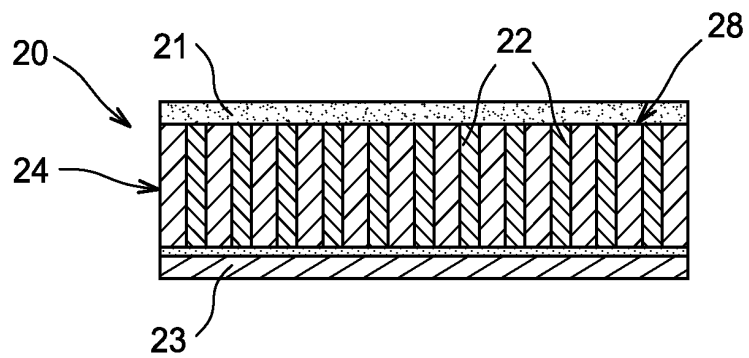
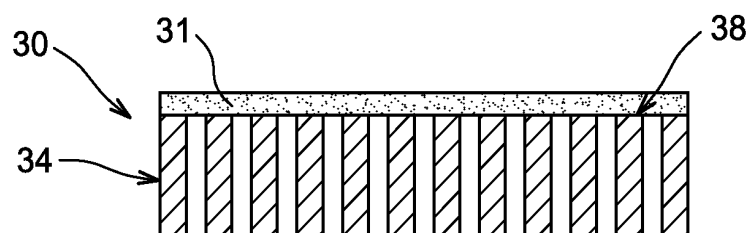


FIG. 3





RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 738803
FR 1055937

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	BABY T T ET AL: "Metal decorated graphene nanosheets as immobilization matrix for amperometric glucose biosensor", SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, vol. 145, no. 1, 4 mars 2010 (2010-03-04), pages 71-77, XP026920949, ISSN: 0925-4005, DOI: DOI:10.1016/J.SNB.2009.11.022 [extrait le 2009-12-11]	19,20	C01B31/02 H01L21/786
A	* page 71, colonne IV, ligne 50 - page 74, colonne VII, ligne 17 * * page 74, colonne VIII, ligne 1 - page 76, colonne XII, ligne 5 *	1-18,21	
A	WO 2009/035213 A1 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) 19 mars 2009 (2009-03-19) * exemples 1,2 *	1-21	
A	US 2009/155561 A1 (CHOI JAE-YOUNG [KR] ET AL) 18 juin 2009 (2009-06-18) * figures 1-5; exemples 1,2 *	1-21	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			C01B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
29 avril 2011		Lecurf, Nicolas	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1055937 FA 738803**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **29-04-2011**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 2009035213 A1	19-03-2009	CN 101835609 A	15-09-2010
		EP 2197676 A1	23-06-2010
		KR 20090026568 A	13-03-2009
		US 2009068471 A1	12-03-2009

US 2009155561 A1	18-06-2009	CN 101462717 A	24-06-2009
		JP 2009143799 A	02-07-2009
		KR 20090065206 A	22-06-2009
